



Транзисторы типа КТ315А, КТ315Б, КТ315В,
КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И,
КТ315Н, КТ315Р

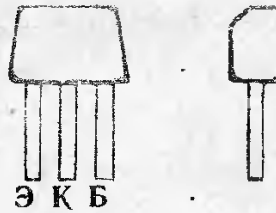


ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные П—Р—П транзисторы типа КТ315А...Р в пластмассовом корпусе изготавливаются для нужд народного хозяйства. Транзисторы КТ315Н предназначены для применения только в цветном телевидении. Транзисторы КТ315Р предназначены для применения только в видеомагнитофонах «Электроника—ВМ».

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1; 1.1; 2; 3; 3.1; 5.1

Схема расположения выводов



Наличие точки в составе маркировки является отличительным знаком транзисторов, предназначенных для цветного телевидения; допускается применение в другой аппаратуре.

Основные электрические параметры при $t=25\pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Тип транзистора	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, (при сопротивлении в цепи эмиттер-база $R_{\text{БЭ}} = 10\text{кОм}$) $U_{\text{К}} = 25\text{В}$ $U_{\text{К}} = 20\text{В}$ $U_{\text{К}} = 40\text{В}$ $U_{\text{К}} = 35\text{В}$ $U_{\text{К}} = 40\text{В}$ $U_{\text{К}} = 35\text{В}$	КТ315А		0,6	
	КТ315 Б, Н		0,6	
	КТ315 В		0,6	
	КТ315 Г, Р		0,6	
	КТ315 Д		1,0	
	КТ315 Е		1,0	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, $U_{\text{К}} = 20\text{В}$ $U_{\text{К}} = 60\text{В}$	КТ315 Ж		0,01	
	КТ315 И		0,1	
Обратный ток коллектора, мкА, ($U_{\text{К}} = 10\text{В}$)	КТ315А...Г,Н,Р		0,5	
	КТ315Д,Е,Ж,И		0,6	
Обратный ток эмиттера, мкА, ($U_{\text{Э}} = 5\text{В}$)	КТ315А...Ж, Н, Р		30	
	КТ315 И		50	
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора ($U_{\text{К}} = 10\text{В}$; $I_{\text{Э}} = 1\text{мА}$)	КТ315А, В	30	120	
	КТ315Б, Г, Е, Н	50	350	
	КТ315 Д	20	90	
	КТ315 Ж	30	250	
	КТ315 И	30	—	
	КТ315 Р	150	350	
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте, ($U_{\text{К}} = 10\text{В}$, $I_{\text{Э}} = 5\text{мА}$, $F = 20\text{мГц}$)	КТ315А...Р	12,5		1

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Тип транзистора	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора, пС, ($U_{к}=10В$, $I_{э}=5мА$, $F=5мГц$)	КТ315 А		300	
	КТ315Б...Г,Н,Р		500	
	КТ315 Д,Е		1000	
	КТ315 Ж		800	
	КТ315 И		950	
	КТ315И		950	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, ($I_{к}=20мА$, $I_{б}=2мА$) ($I_{к}=70мА$, $I_{б}=3,5мА$)	КТ315А...Г,Р		0,4	
	КТ315Д,Е		0,6	
	КТ315Ж		0,5	
	КТ315И		0,9	
	КТ315И		0,4	
	КТ315И		0,4	
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, ($I_{к}=20мА$, $I_{б}=2мА$)	КТ315А...Г,Н,Р		1,0	
	КТ315Д,Е		1,1	
	КТ315Ж		0,9	
	КТ315И		1,35	
	КТ315И		1,35	
	КТ315И		1,35	
Граничное напряжение биполярного транзистора, В, ($I_{э}=5мА$)	КТ315А,Б,Ж,Н	15		
	КТ315В,Д,И	30		
	КТ315Г,Е,Р	25		
Электротермотренировка в течение 168 часов при температуре 100°C	КТ315Р	Режим		
		$I_{к}=7мА$		
		$U_{к}=10В$		

Примечание 1. Для КТ315 Ж, КТ315И величина параметра гарантируется предприятием изготовителем.

Содержание драгоценных металлов в 1000 штук транзисторов:

Золото **70,900** мг.

Цветных металлов не содержится

Сведения о приемке
Транзисторы типов КТ315А..Р соответствуют техническим условиям 3.365.200 ТУ.

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для
штампа ОТК

Место для
штампа ГП

Место для штампа

Перепроверка произведена

дата

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для
штампа ОТК

Место для
штампа ГП